

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月)

## 第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査

☐ PCT規則12.4にいう国際公開

☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの

第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの

第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの

第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ

☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項

☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ

☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項

☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図

☐ 配列表(具体的に記載すること)

☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 1-8	有 無
	請求の範囲	
進歩性 (IS)	請求の範囲	有 無
	請求の範囲 1-8	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 1-8	有 無
	請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

- 文献1: JP 2001-177109 A  
(ルーセント テクノロジーズ インコーポレーテッド)  
2001.06.29, 全文, 第1-25図
- 文献2: JP 2001-203364 A  
(ルーセント テクノロジーズ インコーポレーテッド)  
2001.07.27, 全文, 第1-22図
- 文献3: JP 8-116060 A (株式会社フロンテック)  
1996.05.07, 全文, 第1-18図
- 文献4: JP 2003-505889 A (イー Ink コーポレーション)  
2003.02.12, 全文, 第1-4図
- 文献5: JP 6-89905 A (株式会社半導体エネルギー研究所)  
1994.03.29, 第29段落, 第1図  
&KR 9710652 B1
- 文献6: JP 2000-124462 A (セイコーエプソン株式会社)  
2000.04.28, 第75段落-第105段落, 第14図-第16図  
(ファミリーなし)
- 文献7: JP 4-86891 A (富士ゼロックス株式会社)  
1992.03.19, 全文, 第1-3図 (ファミリーなし)

請求の範囲1~4について

請求の範囲1~4に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献1~3により進歩性を有しない。

文献1~2には、有機半導体層をチャネル領域に形成した、CMOS構造の有機半導体装置について記載されている。

文献3には、P型トランジスタのソース電極及びドレイン電極に仕事関数の大きな材料を用い、N型トランジスタのソース電極及びドレイン電極に仕事関数の小さな材料を用いたCMOS構造の半導体装置について記載されている。

請求の範囲5について

請求の範囲5に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献1~3及び新たに引用する文献5により進歩性を有しない。

文献5には、P型トランジスタのドレイン電極であるアルミニウム配線(124)が、N型トランジスタのソース電極(120)に接続することが記載されている。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

## 請求の範囲 6 について

請求の範囲 6 に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献 1 ～ 3 及び新たに引用する文献 6 により進歩性を有しない。

文献 6 には、P 型トランジスタのドレイン電極と N 型トランジスタのソース電極を配線で接続することが記載されている。

## 請求の範囲 7 について

請求の範囲 7 に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献 1 ～ 4 により進歩性を有しない。

文献 4 には、ゲート電極に導電性ペーストを用いることが記載されている。

## 請求の範囲 8 について

請求の範囲 8 に記載された発明は、国際調査報告書で引用された文献 1 ～ 3 及び新たに引用する文献 7 により進歩性を有しない。

文献 7 には、ドレイン電極に接続された電極が、有機エレクトロルミネセンス表示装置に接続することが記載されている。